# 12

# Экспериментальное исследование концентрационной зависимости диэлектрической проницаемости в трехкомпонентных неупорядоченных системах

### © В.А. Соцков, А.Н. Забавин

Кабардино-Балкарский государственный университет, 360004, Нальчик, Россия e-mail: sozkov\_va@rambler.ru.

(Поступило в редакцию 4 марта 2011 г. В окончательной редакции 23 декабря 2011 г.)

Исследована концентрационная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости для модельной трехкомпонентной системы диэлектрик-полупроводник-проводник. Для действительной части диэлектрической проницаемости обнаружен максимум и предложена качественная модель этого явления.

# Введение

В современной технике широкое применение нашли гетерогенные системы, поэтому часто встает вопрос об их физических свойствах [1,2] и применении этих свойств. Одной из основных задач этих исследований является восстановление функциональной зависимости эффективной диэлектрической проницаемости системы от диэлектрических параметров, геометрических размеров и концентрации компонентов. Исследованию двухкомпонентных систем посвящено значительное количество работ [1,2,3], однако исследования трехкомпонентных систем немногочисленны [4,5] и получены в основном в результате компьютерного моделирования [4].

Целью настоящей работы было экспериментальное исследование диэлектрической проницаемости в трех-компонентных системах диэлектрик-проводник-полу-проводник.

#### Методика эксперимента

Методики изготовления образцов и измерения электрических параметров, которые использовались в работе, довольно подробно описаны [6,7]. Фактически исследовалась диэлектрическая проницаемость смеси, залитой в плоский конденсатор. Следует учитывать, что диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon$  это комплексная величина:

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''. \tag{1}$$

Мнимая часть диэлектрической проницаемости определялась как величина [8]

$$\varepsilon'' = \operatorname{tg} \delta \varepsilon' = \frac{1}{Q} \varepsilon', \qquad (2)$$

где *Q* — добротность конденсатора.

Добротность конденсатора определялась для схемы параллельного соединения конденсатора и сопротивления по стандартной методике. Замеры емкости и добротности производились на частоте 1 kHz. Исследовалась трехкомпонентная система парафин—Fe-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. В качестве проводника использовалось железо, "ч" металлическое восстановленное ТУ 6-09-2227-81. Как известно, оксидная пленка на поверхности железа имеет химический состав Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · nH<sub>2</sub>O [5]. Для того чтобы не увеличивать количества рассматриваемых в системе компонентов, в качестве полупроводника использовался  $A^8B^6$  — (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> "ч") — окись для ферритов ТУ6-09-563-85. Все указанные в работе концентрации объемные. Гранулометрический состав порошков определялся с помощью метода произвольных выборок. Результаты представлены в таблице.

|                                | Железо  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| Основные размеры диаметров     | 4-6     | 24-26                          |
| частиц, µm                     |         |                                |
| Процентное содержание основной | 80      | 60                             |
| группы                         |         |                                |
| Максимальные размеры диаметров | 6-10    | 26 - 34                        |
| частиц, µm                     |         |                                |
| Процентное содержание          | 5       | 15                             |
| Минимальные размеры диаметров  | 0.7 - 4 | 16 - 24                        |
| частиц, µm                     |         |                                |
| Процентное содержание          | 15      | 25                             |

Исследования были проведены до 35% содержания наполнителей (суммарное 70%), так как при больших концентрациях нарушалась целостность образцов, здесь и далее X-объемные концентрации компонентов исследования в более широком диапазоне концентраций наполнителей при применяемой технологии изготовления образцов [6,7] могли привести к получению недостоверных результатов.

## Результаты эксперимента

Результаты исследований представлены на рис. 1, 2. Зависимость  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$ , где  $X_1$  — концентрация Fe в композите,  $X_2$  — концентрация Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, изображена на рис. 1. Наиболее интересен тот факт, что зависимость  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$  не монотонна и имеет максимум  $\lg \varepsilon' \approx 6.51$  при  $X_1 \approx 25\%$ ,  $X_2 \approx 7.51\%$ . При исследовании двухкомпонентного композита парафин-Fe такой закономерности не наблюдалось.  $\lg \varepsilon' = f(X_1)$  — это монотонно возрастающие кривые с насыщением при  $X_1 \ge 45\%$ , причем, для всех исследуемых в работе систем эта зависимость связывается, в основном, с межфрактальной емкостью [7]. Однако следует отметить, что слабо выраженный максимум существует в  $\lg \varepsilon' = f(X_2)$ концентрационной зависимости диэлектрической проницаемости в системе парафин-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (X = 30%) [9]. На рис. 2 изображено сечение поверхности графика *I* 



**Рис. 1.** Концентрационные зависимости действительной части диэлектрической проницаемости для композита парафин-железо- $Fe_2O_3$ .  $X_1$  — объемная доля Fe,  $X_2$  — объемная доля Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.



**Рис. 2.** Сечение поверхности  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$  (рис. 1) плоскостью  $X_2 = 7.51$ .



**Рис. 3.** Концентрационные зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости для композита парафинжелезо- $Fe_2O_3$ .  $X_1$  — объемная доля Fe,  $X_2$  — объемная доля  $Fe_2O_3$ .

плоскостью  $X_2 = 7.51$ , параллельной двум другим осям. Для удобства восприятия оси  $X_1$  и  $X_2$  поменяны местами. При введении проводящего компонента Fe максимум становится очевидно выраженным, однако при этом одновременно возникают очень большие диэлектрические потери (рис. 3). Как видно из рис. 3, экстремумы в зависимости  $\lg \varepsilon'' = f(X_1, X_2)$  отсутствуют и при увеличении концентрации компонентов  $\varepsilon''$  увеличивается и стремится к бесконечности.

# Обсуждение результатов эксперимента

Существование экстремума в зависимости действительной части диэлектрической проницаемости от концентрации вопрос часто обсуждаемый, но до настоящего времени дискуссионный [10–13].

Традиционным является подход, когда при рассмотрении свойств композита, происходит суммирование свойств компонентов по тем или иным законам, например уравнение Лихтенекера и т.д. [8]. Однако, с точки зрения объемной поляризации и суммирования свойств компонентов, полученные результаты (максимум  $\varepsilon'$ , рост  $\varepsilon''$ ) трудно объяснимы. Это вызвано тем, что с ростом концентрации любого компонента должно наблюдаться и увеличение рассматриваемых свойств этого компонента. При этом не учитывается, что компонент может обладать различными взаимосвязанными свойствами, например проводимость и действительная часть диэлектрической проницаемости. В данном случае существование максимума возможно, если наряду с механизмами увеличения є' существуют и механизмы его уменьшения. Из рис. 1,3 видно, что наряду с ростом  $\varepsilon'$  существует какой-то другой конкурирующий процесс, который приводит к понижению  $\varepsilon'$ , но к резкому росту  $\varepsilon''$  в области максимума  $\varepsilon'$ . Можно предположить, что процесс возникновения максимума обусловлен, с одной стороны, поверхностной поляризацией (Максвелла—Вагнера) [14,15]. Поверхностная поляризация возникает тогда, когда граничащие диэлектрики, диэлектрики—полупроводники или подобные структуры имеют различную проводимость, поэтому для прохождения тока постоянной плотности необходимы различные градиенты напряжения [14,15] и, как следствие, существует возможность накопления зарядов на границе, предположительно, частиц Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> или парафина.

Экспериментально определенное удельное сопротивление составило: парафина  $\rho = 1 \cdot 10^{11} \,\Omega m$ , для порошкообразного Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  $\rho = 1 \cdot 10^5 \,\Omega$ m, для Fe  $\rho =$  $= 9.71 \cdot 10^{-4} \Omega m$  [9,16], т.е. компоненты соответствуют условию различной проводимости. В работе [9] исследована система парафин — Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, проводимость в которой модифицировалась графитом. При проводимости композита  $\rho < 10^6 \,\Omega m$  наблюдалось падение величины  $\varepsilon'$ . В смеси существует два конкурирующих процесса: накопление заряда на границе, предположительно, частиц Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> или парафина и стекание заряда на электроды. При достижении определенной проводимости в смеси (в данном случае  $\rho < 1.76 \,\Omega m \, [5]$ ) в районе максимума превалирующим процессом становится не накопление, а стекание зарядов с поверхности полупроводника или диэлектрика. Подтверждением предложенной модели является зависимость  $\lg \varepsilon'' = f(X_1, X_2)$  (рис. 3). В области максимума lg  $\varepsilon' = f(X_1, X_2)$  (рис. 1) для lg  $\varepsilon'' = f(X_1, X_2)$ наблюдается значительный рост, что, безусловно, определяется ростом проводимости смеси. В подавляющем большинстве современных теоретических работ [17,18] зависимость є' от проводимости вообще не рассматривается. Однако в экспериментальной работе [19] для системы парафин-графит показана такая зависимость и предложена аппроксимация для зависимости  $\lg \varepsilon' = f(x)$ как до порога перколяции, так и после него.

Кроме того, вблизи точки перколяционного перехода (для Fe  $X_1 \approx 0.15$ , для Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  $X_2 \approx 0.1$  [5]) имеется интересная особенность. На рис. 3 по линии  $X_2 \approx 0.1$  (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) рост  $\varepsilon''$  не столь интенсивен при  $X_1 < 0.15$  как по другим направлениям, в результате чего образуется складка на графике. На рис. 1 эта особенность имеется, но менее выражена. О предсказании возможности особенностей в районе перколяционного перехода существует множество теоретических предсказаний [10-13], которые не всегда оправдываются в эксперименте [7]. Можно предположить, что при концентрации  $Fe_2O_3 X_2 \approx 0.1$  даже при росте содержания Fe рост потерь (эквивалентно рост проводимости в рассматриваемой схеме замещения) идет медленнее из-за более интенсивного захвата носителей электричества на поверхности компонентов частиц Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> или парафина, чем при других концентрациях Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в трехкомпонентной системе. Причина такой избирательности может лежать в еще не исследованных особенностях поляризации Максвелла-Вагнера в районе перколяционного перехода.

## Выводы

В результате проведенных работ обнаружено:

1. В зависимости  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$ , где  $X_1$  — концентрация Fe в композите,  $X_2$  — концентрация Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, обнаружен максимум при  $X_1 \approx 25\%$ ,  $X_2 \approx 7.51\%$ .

2. В зависимости  $\lg \varepsilon'' = f(X_1, X_2)$  в районе максимума функции  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$  значительный рост мнимой части диэлектрической проницаемости.

Безусловно, для композита парафин-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Fe имеются два вида релаксации — объемная и поверхностная (Максвелла-Вагнера), и полученный результат (существование максимума) следует рассматривать как сумму вышеупомянутых механизмов. Существование максимума в зависимости  $\lg \varepsilon' = f(X_1, X_2)$  можно объяснить двумя конкурирующими процессами в поверхностной поляризации: с одной стороны, накоплением зарядов на поверхности частиц, а с другой — стеканием зарядов за счет увеличения проводимости системы.

## Список литературы

- [1] Харитонов Е.В. Диэлектрические материалы с неоднородной структурой. М.: Радио и связь. 1983. 128 с.
- [2] Чмутин И.А., Летягин С.В., Шевченко В.Г., Пономаренко А.Т. Высокомолекулярные соединения. 1994. Т. 36. № 4, С. 699–713.
- [3] Гуль В.Е., Шенфень Л.З. Электропроводящие полимерные композиции. М.: Химия. 1984. С. 37.
- [4] Ioselevich A.S. // Phys. Rev. Lett. 1995.V 74. N 8. P. 1411–1414.
- [5] Соцков В.А. // ЖТФ. 2009. Т.79. Вып.6. С. 146-149.
- [6] Соцков В.А., Борисов В.А. // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 11. С. 103–107.
- [7] Соцков В.А. // ФТП. 2005. Т. 39. Вып. 2. С. 269.
- [8] Пасынков В.В. Материалы электронной техники. М.: Высшая школа, 1980. С. 155–160.
- [9] Соцков В.А. // Поверхность. 2010. № 10. С. 83-85.
- [10] Efros A.L., Shkovskii B.I. // Phys. Stat. Sol. B. 1976. Vol. 76. P. 475.
- Дубров В.Е., Левинитейн М.Е., Шур М.С. // ЖЭТФ. 1976.
  Т. 70. Вып. 5. С. 2014–2023.
- [12] Неймарк А.В. // ЖЭТФ. 1990. Т. 98. Вып. 2(8). С. 611-625.
- [13] Виноградов А.П., Каримов А.М., Сарычев А.К. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. Вып. 10. С. 301–308.
- [14] Хиппель А.Р. Диэлектрики и волны. М.: ИИЛ, 1960. 440 с.
- [15] Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Физматгиз, 1963. С. 175.
- [16] Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1005 с.
- [17] Борисов В.С., Аграфонов Ю.И., Щербаченко Л.А. и др. // ФТТ. 2011. Т. 53. Вып. 1. С. 52–57.
- [18] Богатин А.С., Лисица И.В., Богатина С.А. // Письма в ЖТФ. 2002. Т 28. Вып. 18. С. 61-66.
- [19] Соцков В.А. // ЖТФ. 2005. Т. 75. Вып. 6. С. 134–135.